



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

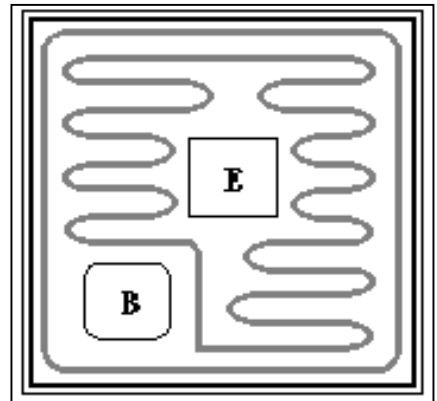
H8550

对应国外型号
S8550

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
 芯片代码：A063AJ-00-XXX
 芯片厚度：240 ± 20μm
 管芯尺寸：600 × 600μm²
 焊位尺寸：B 极 130×150μm；E 极 140×130μm
 电极金属：铝
 背面金属：金
 封装形式：TO-92

芯片图



极限值 (T_a=25)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
 T_j——结温..... 150
 P_C——集电极耗散功率..... 1W
 V_{CBO}——集电极—基极电压.....-40V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压.....-25V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....-6V
 I_C——集电极电流.....-1.5A

电参数 (T_a=25)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
ICBO	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	V _{CB} =-35V, I _E =0
IEBO	发射极—基极截止电流			-0.1	μA	V _{EB} =-6V, I _C =0
HFE	直流电流增益	85		500		V _{CE} =-1V, I _C =-100mA
		40				V _{CE} =-1V, I _C =-800mA
VBE(ON)	基极—发射极导通电压			-1.0	V	V _{CE} =-1V, I _C =-10mA
VCE(sat)	集电极—发射极饱和电压			-0.5	V	I _C =-800mA, I _B =-80mA
VBE(sat)	基极—发射极饱和电压			-1.2	V	I _C =-800mA, I _B =-80mA
BVCBO	集电极—基极击穿电压	40			V	I _C =-100μA, I _E =0
BVCEO	集电极—发射极击穿电压	25			V	I _C =-2mA, I _B =0
BVEBO	发射极—基极击穿电压	6			V	I _E =-100μA, I _C =0
fT	特征频率	100			MHz	V _{CE} =-10V, I _C =-50mA